

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия наук
Научный совет по физике конденсированных сред
Секция "Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков"
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
(Технический университет)
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

**ХII Международная конференция
ФИЗИКА ДИЭЛЕКТРИКОВ
(ДИЭЛЕКТРИКИ-2011)**

Санкт-Петербург, 23 – 26 мая 2011 г.

**ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
И
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ**

РГПУ им. А.И. Герцена
Санкт-Петербург
2011

Уважаемый (ая) _____

Приглашаем Вас принять участие в работе XII Международной конференции «Физика диэлектриков (Диэлектрики-2011)».

Открытие конференции состоится 23 мая в 10³⁰ в Колонном зале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.48, корпус 5 (станция метро «Невский проспект», выход на канал Грибоедова).

Заседания секций будут проходить в Большом конференц-зале, Колонном и в Дискуссионном залах РГПУ им. А.И. Герцена.

Стендовые доклады будут располагаться в малом холле корпуса 5.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Регистрация участников конференции будет проводиться:

- 22 мая с 9 до 21 часа в холле гостиницы РГПУ им. А.И. Герцена по адресу: Казанская ул., д.6 (ст. метро «Невский проспект»);
- 23 мая с 9 до 10⁰⁰ часов в Колонном зале РГПУ им. А.И. Герцена.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Время, выделяемое на произносимые доклады, – 15-20 минут. В распоряжение докладчика предоставляется мультимедиа-проектор. Для стендовых докладов выделяется место размером 50 x 70 см².

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ

День заезда – 22 мая 2011 г.

Заккрытие конференции – 26 мая 2011 г.

День отъезда – 26 мая 2011 г.

Для иногородних участников конференции могут быть зарезервированы места в гостинице РГПУ им. А.И. Герцена или других гостиницах города при условии своевременной оплаты оргвзноса и наличия заполненной заявки.

**Председатель Оргкомитета
«Диэлектрики-2011»**

Г.А. Бордовский

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ «ДИЭЛЕКТРИКИ-2011»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Бордовский Г.А. президент РГПУ им. А.И. Герцена, академик РАО, профессор (Санкт-Петербург)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

Гороховатский Ю.А. зав. каф. РГПУ им. А.И. Герцена, профессор (Санкт-Петербург)

Закревский В.А. зам. директора отделения ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, профессор (Санкт-Петербург)

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Темнов Д.Э. доцент РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Аванесян В.Т. профессор РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

Андреев А.М. профессор СПбГПУ (Санкт-Петербург)

Анисимова Н.И. доцент РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

Афанасьев В.П. зав. каф. профессор СПбГЭТУ (ЛЭТИ) (Санкт-Петербург)

Барабан А.П. профессор СПбГУ (Санкт-Петербург)

Борисова М.Э. профессор СПбГПУ (Санкт-Петербург)

Гриценко В.А. гл. научн. сотр. ИФП СО РАН (Новосибирск)

Гуртов В.А. зав. каф. ПетрГУ, профессор (Петрозаводск)

Дебердеев Р.Я. зав. каф. КазГТУ, профессор (Казань)

Звягин И.П. профессор МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)

Коноров П.П. профессор СПбГУ (Санкт-Петербург)

Лаптев В.В. проректор РГПУ им. А.И. Герцена, академик РАО, профессор (Санкт-Петербург)

Леманов В.В. гл. науч. сотр. ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, профессор (Санкт-Петербург)

Лущейкин Г.А. профессор МГУПИ (Москва)

Марков Ю.Ф. гл. науч. сотр. ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург)

Немов С.А. профессор СПбГПУ (Санкт-Петербург)

Никифоров К.Г. проректор КГУ, профессор (Калуга)

Рычков А.А. зав. каф. РГПУ им. А.И. Герцена, профессор (Санкт-Петербург)

Серегин П.П. профессор РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

Соломин В.П. ректор РГПУ им. А.И. Герцена, профессор (Санкт-Петербург)

Струков Б.А. профессор МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)

Теруков Е.И. зав. лаб. ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, профессор (Санкт-Петербург)

Ханин С.Д. зав. каф. РГПУ им. А.И. Герцена, профессор (Санкт-Петербург)

Цобкалло Е.С. зав. кафедрой СПбГУТиД, профессор (Санкт-Петербург)

Чугуева И.Н. зам. председателя Научного совета РАН по физике конденсированных сред (Москва, Россия)

Юдин В.Е. зав. лаб. ИВС РАН, профессор (Санкт-Петербург)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ «ДИЭЛЕКТРИКИ-2011»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Сигов А.С. ректор МИРЭА, чл.-корр. РАН, профессор, председатель секции «Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков» Научного совета РАН по физике конденсированных сред (Москва, Россия)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

Волк Т.Р. зав. лаб. ИКАН, профессор (Москва, Россия)

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:

Герхард Р. профессор (Потсдам, Германия)
Гольдаде В.А. профессор (Гомель, Беларусь)
Евтич М. профессор (Косовска Митровица, Сербия)
Кастро Р.А. профессор (Гавана, Куба)
Коугия К. профессор (Саскачеван, Канада)
Кумекон С.Е. профессор (Алматы, Казахстан)
Назаров А.Н. профессор (Киев, Украина)
Поплавко Ю.М. профессор (Киев, Украина)

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Процессы переноса, накопления и релаксации заряда в диэлектриках.
2. Оптика и спектроскопия диэлектриков.
3. Электрофизика структур, содержащих диэлектрические слои.
4. Электронные и оптические явления в наноструктурированных диэлектриках.
5. Аморфные и стеклообразные диэлектрики.
6. Полимерные композиционные диэлектрики.
7. Электретный эффект и его применение.
8. Диэлектрики в экстремальных условиях.
9. Физические основы и методы диагностики и технологии изготовления диэлектриков.

В рамках программы конференции планируется проведение круглого стола «Физика диэлектриков в системе высшего профессионального образования».

ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

23 мая, понедельник

9.00-10.30		Регистрация участников	Колонный зал
10.30-11.00		Открытие конференции	Колонный зал
11.00-13.00		Пленарное заседание	Колонный зал
13.00-14.00	Перерыв		
14.00-17.00		Пленарное заседание	Колонный зал

24 мая, вторник

09.00-10.00	C1	Представление стендовых докладов секции «Процессы переноса, накопления и релаксации заряда в диэлектриках»	Малый холл корпуса 5
	C9	Представление стендовых докладов секции «Физические основы и методы диагностики и технологии изготовления диэлектриков»	Малый холл корпуса 5
10.00-13.00	П1	1-е заседание секции «Процессы переноса, накопления и релаксации заряда в диэлектриках»	Большой конференц-зал
	П9	Заседание секции «Физические основы и методы диагностики и технологии изготовления диэлектриков»	Дискуссионный зал
13.00-14.00	Перерыв		
14.00-15.00	C4	Представление стендовых докладов секции «Электронные и оптические явления в наноструктурированных диэлектриках»	Малый холл корпуса 5
15.00-17.30	П1	2-е заседание секции «Процессы переноса, накопления и релаксации заряда в диэлектриках»	Большой конференц-зал
	П4	Заседание секции «Электронные и оптические явления в наноструктурированных диэлектриках»	Дискуссионный зал

25 мая, среда

09.00-10.00	C2	Представление стендовых докладов секции «Оптика и спектроскопия диэлектриков»	Малый холл корпуса 5
	C5	Представление стендовых докладов секции «Аморфные и стеклообразные диэлектрики»	Малый холл корпуса 5
10.00-13.00	П2	1-е заседание секции «Оптика и спектроскопия диэлектриков»	Большой конференц-зал
	П5	Заседание секции «Аморфные и стеклообразные диэлектрики»	Дискуссионный зал
13.00-14.00	Перерыв		

14.00-15.00	С7	Представление стендовых докладов секции «Электретный эффект и его применение»	Малый холл корпуса 5
15.00-17.30	П2	2-е заседание секции «Оптика и спектроскопия диэлектриков»	Большой конференц-зал
	П7	Заседание секции «Электретный эффект и его применение»	Дискуссионный зал
19.00		Товарищеский ужин	

26 мая, четверг

09.00-10.00	С8	Представление стендовых докладов секции «Диэлектрики в экстремальных условиях»	Малый холл корпуса 5
	С6	Представление стендовых докладов секции «Полимерные композиционные диэлектрики»	Малый холл корпуса 5
10.00-13.00	П8	Заседание секции «Диэлектрики в экстремальных условиях»	Большой конференц-зал
	П6	Заседание секции «Полимерные композиционные диэлектрики»	Дискуссионный зал

13.00-14.00 Перерыв

14.00-15.00	С3	Представление стендовых докладов секции «Электрофизика структур, содержащих диэлектрические слои»	Малый холл корпуса 5
15.00-17.00	П3	Заседание секции «Электрофизика структур, содержащих диэлектрические слои»	Большой конференц-зал
	КС	Круглый стол «Физика диэлектриков в системе образования»	Дискуссионный зал
17.30		Закрытие конференции	Большой конференц-зал

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

22 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9⁰⁰ – 21⁰⁰ День заезда и регистрация иногородних участников конференции (холл гостиницы РГПУ, ул. Казанская, д.6)

23 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

9⁰⁰ – 10³⁰ Регистрация участников конференции (Колонный зал, наб. реки Мойки, д.48, к.5)

10³⁰ – 11⁰⁰ **Открытие конференции** (Колонный зал)

1. Вступительное слово председателя Оргкомитета конференции, президента РГПУ им. А.И. Герцена, академика РАО **Бордовского Геннадия Алексеевича**
2. Приветственное слово председателя Международного программного комитета конференции, ректор МИРЭА, чл.-корр. РАН, профессора, **Сигова Александра Сергеевича**
3. Информация Оргкомитета конференции

11⁰⁰ – 13⁰⁰ **Пленарное заседание** (Колонный зал)

Руководитель заседания: Гороховатский Юрий Андреевич
(РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург)

Ученый секретарь: Темнов Дмитрий Эдуардович
(РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург)

1. **Афанасьев В.П., Крамар Г.П., Петров А.А., Чигирев Д.А., Федоров К.А.** Электронные и фотоэлектрические явления в наноструктурированных пленках ЦТС с избытком свинца (Санкт-Петербург, Россия, ЛЭТИ)
2. **Малиновский В.К., Попова В.А., Суровцев Н.В.** Стеклообразные диэлектрики: структура, свойства, явления переноса (Новосибирск, Россия, Институт автоматики и электрометрии СО РАН)
3. **Марков Ю.Ф.** Фазовые переходы, параметр порядка и его флуктуации в модельных кристаллах Hg₂NaI₂ (Санкт-Петербург, Россия, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН)
4. **Богатин А.С., Турик А.В., Богатина В.Н., Андреев Е.В., Ковригина С.А.** Сильные и слабые релаксационные поляризации (Ростов-на-Дону, Россия, физический факультет Южного федерального университета)
5. **Гриценко В.А.** Электронные свойства флэш-памяти на основе диэлектриков с высокой диэлектрической проницаемостью (Новосибирск, Россия, Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН)

13⁰⁰ – 14⁰⁰ Перерыв

14⁰⁰ – 17⁰⁰ **Пленарное заседание** (Колонный зал)

Руководитель заседания: Гороховатский Юрий Андреевич
(РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург)

Ученый секретарь: Темнов Дмитрий Эдуардович
(РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург)

6. **Reimund Gerhard** Dielectric elastomers, polymeric space-charge electrets, polymer piezoelectrets and piezoelectric polymers for electromechanical coupling (Potsdam, Germany, University of Potsdam)
7. **Писарев Р.В.** Линейные и нелинейные оптические явления в диэлектриках-мультиферроиках. (Санкт-Петербург, Россия, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН)
8. **Ханин С.Д.** Нелинейные электронные свойства и характеристика наноразмерных кристаллов в некристаллических средах. (Санкт-Петербург, Россия, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена)
9. **Дебердеев Р.Я., Дебердеев Т.Р., Улитин Н.В.** Особенности детектирования структурных и релаксационных переходов при формировании густосетчатых эпоксиаминных полимеров. (Казань, Россия, Казанский государственный технологический университет)
10. **Таганцев А.К.** Флексоэлектричество (Санкт-Петербург, Россия, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН; Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Ceramics Laboratory, CH-1015 Lausanne, Switzerland)

24 МАЯ, ВТОРНИК

- 9⁰⁰ – 10⁰⁰ Представление стендовых докладов секций «Процессы переноса, накопления и релаксации заряда в диэлектриках» (С1) и «Физические основы и методы диагностики и технологии изготовления диэлектриков» (С9) (Малый холл корпуса 5)
- C.1.1 Александров О.В., Дусь А.И. Механизм образования фиксированного заряда в системе Si-SiO₂
 - C.1.2 Алексеев А.Н., Лазаренко М.М., Рацборская А.А., Безродная Т.В., Пучковская Г.О. Особенности диэлектрической релаксации в поликристаллах ЦТАБ
 - C.1.3 Андрюшина И.Н., Юрасов Ю.И., Резниченко Л.А., Дудкина С.И. Диэлектрический отклик ЦТС-керамик в диапазонах температур (10÷1000)К и частот (1·10⁻²÷2·10⁷)Гц
 - C.1.4 Атакулов Ш.Б., Зайнолобидинова С.М., Пўлатов Ю.П., Холматова Д. Прозрачность потенциального барьера на границах зерен в керамиках типа титаната бария в области фазового перехода полупроводник – сегнетоэлектрик
 - C.1.5 Богатин А.С., Богатина В.Н., Андреев Е.В., Ковригина С.А. Модуль отклика при релаксационной поляризации
 - C.1.6 Волков А.С., Копосов С.Г. Эффективность влияния диссоциирующих примесей на диэлектрическую проницаемость мерзлого порошка кварца
 - C.1.7 Горбатенко В.В., Кудряш В.И., Прасолов Б.Н. Эффект пиннинга доменных границ в кристаллах группы А₂ВХ₄ вблизи точки Кюри
 - C.1.8 Горбатенко В.В., Кудряш В.И., Прасолов Б.Н. Исследование процессов переполяризации в окрестности температуры замораживания доменной структуры кристалла Rb₂ZnCl₄ методом гармонического анализа
 - C.1.9 Горбатенко С.А., Прасолов Б.Н., Горбатенко В.В. Исследование динамики доменных границ в кристаллах группы А₂ВХ₄ методом гармонического анализа
 - C.1.10 Еремин Е.В., Волков Н.В., Саблина К.А. Диэлектрические и транспортные свойства монокристалла Pb₃Mn₇O₁₅

- C.1.11 Ерин К.В. Исследование приэлектродного объемного заряда в магнитных коллоидах на основе жидких диэлектриков
- C.1.12 Коноров П.П., Селиверстова О.А. Электрофизика мембранных процессов. Перенос водорода через полупроводниковые и диэлектрические мембраны
- C.1.13 Копосов Г.Д., Тягунин А.В., Копосов Д.Г. Оценка вклада квазиплазменных колебаний в диэлектрическую проницаемость мерзлых влагосодержащих дисперсных сред
- C.1.14 Копосов Г.Д., Софронов Е.Л. Спиновой парамагнетизм диспергированных диэлектриков
- C.1.15 Куприянова Т.А., Лямина О.И., Миникаев Л.Р., Тангишев Р.Р., Степович М.А., Филиппов М.Н. О некоторых аспектах математического моделирования процесса накопления электрического заряда диэлектрической мишенью при её облучении киловольтными электронами
- C.1.16 Майорова Т.Л., Ключев В.Г., Фам Тхи Хаи М., Михалевский А.А. Эффект длительной релаксации фотовозбужденной проводимости в пиролитических пленках CdS
- C.1.17 Масловская А.Г., Барабаш Т.К., Сивунов А.В. Оценка мультифрактальных характеристик процесса реполяризации сегнетоэлектрических кристаллов при электронном облучении
- C.1.18 Махмудов Х.Ф. Механо-электрические эффекты при слабой электрической поляризации и при упругой деформации образцов из твердых диэлектриков (горных пород)
- C.1.19 Миллер А.И., Вербенко И.А. Термочастотные характеристики керамик многокомпонентной системы на основе PMN, PZN, PNN
- C.1.20 Мкртчян Л.С., Закинян А.Р., Диканский Ю.И. Капиллярная электростатическая неустойчивость слоя магнитодиэлектрического коллоида в электрическом и магнитном полях
- C.1.21 Новик В.К., Лотонов А.М., Гаврилова Н.Д. 3-D портрет зависимости $\text{tg}\delta(f,T)$ сегнетоэлектрика с разными типами доменов вблизи фазового перехода (на примере диглициннитрата)
- C.1.22 Новиков Ю.Н. Двухзонная проводимость Si_3N_4 : эксперимент и численное моделирование
- C.1.23 Павленко А.В., Захарченко И.Н., Константинов Г.М. Низкотемпературная релаксация в керамике $\text{Bi}_{0.5}\text{La}_{0.5}\text{MnO}_3$
- C.1.24 Пирозерский А.Л., Чарная Е.В., Даско С., Недбай А.И., Лебедева Е.Л., Латышева Е.Н. Диэлектрические свойства кристаллов иодата лития, выращенных из растворов различной кислотности
- C.1.25 Плотников В.В., Комлев А.Е., Шаповалов В.И., Шутова Н.С. Электропроводность аморфных оксидных плёночных гетероструктур, содержащих слои Ta_2O_5 и TiO_2
- C.1.26 Пономарев А.Ф., Накаряков А.С. Определение ловушечных состояний в запрещенной зоне полимера
- C.1.27 Пономарев Р.С., Кичанов А.В., Журавлев А.А. Интерферометрическое исследование релаксации заряда в кристалле ниобата лития
- C.1.28 Прокопьев Е.П. Комплексы уилера в полупроводниках и ионных кристаллах

- C.1.29 Садовничий Д. Н., Гусев С.А., Милёхин Ю.М. Теоретический анализ накопления объемных зарядов в политетрафторэтилене при электронном облучении
- C.1.30 Семкин Н.Д., Телегин А.М., Воронов К.Е. Проводимость и ионообразование в трехслойных структурах металл – диэлектрик – металл в условиях воздействия высокоскоростных пылевых частиц
- C.1.31 Турик А.В., Богатин А.С., Андреев Е.В., Игнатова Ю.А. Взаимосвязь частотных областей дисперсий диэлектрической проницаемости и проводимости
- C.1.32 Ханин С.Д., Семенович И. Частотная зависимость перколяционных параметров пленок VO_2 при фазовом переходе диэлектрик-металл
- C.1.33 Шадрин Е.Б., Попова И.О., Кириков Н.В. Термоимпедансметрия параметров фазового перехода полупроводник-суперионный проводник в пленках йодида серебра
- C.1.34 Шапиро С.В., Саенко А.Г. Использование высокочастотных релаксационных процессов в технологии плазмохимической активации полиолефиновых диэлектриков
- C.1.35 Шутова Н.С., Плотников В.В., Комлев А.Е., Шаповалов В.И. Фотовозбуждение в пленочной гетероструктуре TiO_2/WO_3
- C.9.1 Fedosov S.N., Sergeeva A.E. Application of corona discharge for poling ferroelectric and nonlinear optical polymers
- C.9.2 Андреев В.В., Михальков А.М., Коротров С.И., Романов А.В. Метод многоуровневой токовой нагрузки для исследования диэлектрических пленок МДП-структур
- C.9.3 Андреев Д.А., Дмитриков В.Ф., Красильщиков М.Я., Смирнов В.Ф. Исследование перспективных диэлектриков керамических конденсаторов и фильтров на их основе
- C.9.4 Андреев И.А, Млынчик В.И. Идентификация типов дефектов изоляции по характеристикам частичных разрядов
- C.9.5 Андреев П.В., Истомин Л.А., Фаддеев М.А. Уточнение атомной структуры примесных кристаллов кубического диоксида циркония
- C.9.6 Антоненко А.Х., Аржанникова С.А., Володин В.А., Ефремов М.Д., Камаев Г.Н. Особенности роста и свойства пленок SiO_2 при плазменном окислении поверхности кремния
- C.9.7 Бедняков П.С., Шнайдштейн И.В., Струков Б.А. Исследование сегнетоэлектрического фазового перехода в кристалле триглицинсульфата методом тепловых шумов
- C.9.8 Безбородов А.А. Изучение основных электрофизических характеристик новых типов электромишинной изоляции
- C.9.9 Березина О.Я., Величко А.А., Зломанов В.П., Казакова Е.Л., Ненаншев Р.В., Путролайнен В.В., Артюхин Д.В. Свойства пленок диоксида ванадия, полученных золь-гель методом
- C.9.10 Журавлева Н.М., Сажин Б.И., Муравьева Т.Н., Смирнова Е.Г., Пазухина Г.А. Модификация целлюлозной бумаги с целью совершенствования электрофизических свойств пропитанных органических диэлектриков

- C.9.11 Козырев А.Б., Алтынников А.Г., Гагарин А.Г. Релаксация объёмного заряда в сегнетоэлектрических конденсаторах при воздействии ультрафиолетового излучения
- C.9.12 Курашев С.М. Оптическое определение скорости звука в прозрачных диэлектриках
- C.9.13 Кустов А.И., Мигель И.А. Физические основы методов акустомикроскопической дефектоскопии и их применение для диагностики диэлектрических материалов
- C.9.14 Малышкина О.В., Мовчикова А.А., Калугина О.Н. Определение коэффициента тепловой диффузии сегнетоэлектрических материалов пироэлектрическим методом
- C.9.15 Платонова И.В., Бедняков П.С., Тараскин С.А., Данилов А.Ю., Пахомов П.М. Использование метода тепловых шумов для исследования диэлектрических свойств пленок полимерных композитов
- C.9.16 Разумная А.Г., Куприянов М.Ф., Кабиров Ю.В., Рудская А.Г., Кофанова Н.Б. Эффекты изоморфного замещения в твердых растворах $PbTi_{1-x}Mn_xO_3$
- C.9.17 Рудская А.Г., Разумная А.Г., Назаренко А.В., Куприянов М.Ф., Кабиров Ю.В., Залетов В.Г., Тесленко П.Ю., Кофанова Н.Б., Кладенок Л.А. О корреляции анизотропии связей и параметре Ланде в твердых растворах классических мультиферроиков $BiFeO_3$ и $YMnO_3$
- C.9.18 Соколова С.А., Дьяконова О.В., Зяблов А.Н. Исследование состояния поверхности полимерных диэлектрических пленок и мембран методом сканирующей зондовой микроскопии
- C.9.19 Чупахина Е.А., Яковлева Н.М., Яковлев А.Н. Композитные диэлектрические анодно-оксидные покрытия на алюминиевых сплавах
- C.9.20 Шнайдштейн И.В., Бедняков П.С., Струков Б.А. Особенности применения метода тепловых шумов при исследовании диэлектрических свойств сегнетоэлектриков

10⁰⁰ – 13⁰⁰ **Первое заседание секции «Процессы переноса, накопления и релаксации заряда в диэлектриках» (П1) (Большой конференц-зал)**

Руководители секции: Ханин Самуил Давидович
(РГПУ им. А.И. Герцена)
Звягин Игорь Петрович
(МГУ им. М.В. Ломоносова)

Ученый секретарь: Попова Ирина Олеговна
(РГПУ им. А.И. Герцена)

Произносимые доклады:

- П.1.1 **Венедиктов В.А., Звягин И.П.** Влияние ориентационного беспорядка на транспорт в неупорядоченных органических полупроводниках (Москва, Россия, МГУ)
- П.1.2 **Королев Н.А.¹, Никитенко В.Р.¹, Тютнев А.П.²** Моделирование нестационарной близнецовой рекомбинации в полимерах методом Монте-Карло (Москва, Россия, ¹Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», ²Московский государственный институт электроники и математики (технический университет))

- П.1.3 **Барыбин А.А., Завьялов А.В., Шаповалов В.И.** Модель релаксации заряда в диэлектрической пленке (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»)
- П.1.4 **Борисова М.Э.** Анализ абсорбционных характеристик диэлектриков при непрерывной зависимости проводимости от координаты (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
- П.1.5 **Ильинский А.В.¹, Ханин С.Д.², Шадрин Е.Б.¹** Переход Мотта как первичная стадия фазового перехода металл-диэлектрик в диоксиде ванадия (Санкт-Петербург, Россия, ¹Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, ²РГПУ им. А.И. Герцена)
- П.1.6 **Мелешенко П.А., Долгих А.В., Ханг Т.Т. Нгуен, Клиньских А.Ф.** Особенности переноса заряда в квантовых интерференционных устройствах (Воронеж, Россия, Воронежский государственный университет)
- П.1.7 **Ханг Т.Т. Нгуен, Долгих А.В., Мелешенко П.А., Клиньских А.Ф.** Поляризуемость квантового каскада (Воронеж, Россия, Воронежский государственный университет)
- П.1.8 **Стефанович Г.Б., Пергамент А.Л. Величко А.А. Стефанович. Т.Г.** Зарядоперенос в оксидных гетероструктурах (Петрозаводск, Россия, Петрозаводский государственный университет)
- П.1.9 **Кочервинский В.В.¹, Чубунова Е.В.², Лебединский Ю.Ю.², Шмакова Н.А.¹** Особенности контактной поляризации в неполярных и полярных полимерах (Москва, Россия, ¹ФГУП НИФХИ им. Л.Я.Карпова, ²МИФИ НИЯУ)

Репортерское сообщение по стендовым докладам

- 10⁰⁰ – 13⁰⁰ **Заседание секции «Физические основы и методы диагностики и технологии изготовления диэлектриков» (П9) (Дискуссионный зал)**
 Руководители секции: Андреев Александр Михайлович (ОАО «Силовые машины»)
 Ученый секретарь: Демидов Евгений Владимирович (РГПУ им. А.И. Герцена)

Произносимые доклады:

- П.9.1 **Арсентьев М.Ю., Тихонов П.А., Калинина М.В., Цветкова И.Н., Шилова О.А., Андреева Н.С.** Синтез и физико-химические свойства электродных и электролитных нанокompозитов для химических энергонакопителей (Санкт-Петербург, Россия, Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН)
- П.9.2 **Степанов Ю.М., Бурда В.В.** Диэлектрическое исследование полимерных композитов на основе полипропилена (Россия, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена)
- П.9.3 **Безбородов А.А., Шикова Т.М., Красикова Т.А.** Влияние технологических факторов на теплопроводность системы изоляции (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
- П.9.4 **Пщелко Н.С.** Неразрушающий контроль прочности электроадгезионных соединений ионный диэлектрик – проводник (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-

Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет))

- П.9.5 **Vera Petrović¹, Aleksandar Žorić², Hranislav Milošević³, Slobodan Obradović⁴** Synthesis and structure of dielectric ceramics systems MgCO₃-TiO₂ (¹Belgrade, Serbia, School of Electrical Engineering and Computer Science of Applied Studies; ²Kosovska Mitrovica, Serbia, Faculty of Engineering University of Priština; ³ Kosovska Mitrovica, Serbia, Faculty of Mathematical University of Priština; ⁴ Belgrade, Serbia, Faculty of Computer Science, University Megatrend)
- П.9.6 **Мовчикова А.А.¹, Малышкина О.В.¹, Пензов К.Н.¹, Шашков М.¹, Steinhausen R.², Langhammer H.T.², Beige H.²** Диэлектрические свойства керамики BTS с градиентом состава (¹Тверь, Россия, Тверской государственный университет; ²Хале, Германия, Институт физики Университета Мартина-Лютера)
- П.9.7 **Богоносков К.А., Дмитриева В.Ф., Максимовский С.Н.** Технология высокоскоростного выращивания диэлектриков на аморфных подложках (Москва, Россия, Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского)
- П.9.8 **Poplavko Y.M., Prokopenko Y.V., Voronov S.A.** Ferroelectrics for non-hysteresis tuning of microwave devices (Kiev, Ukraine, National Technical University of Ukraine "KPI")
- П.9.9 **Soltamov V.A., Ilyin I.V., Soltamova A.A., Tolmachev D.O., Mokhov E.N., Khramtsov V.A., Baranov P.G.** Defects in ALN single crystals: EPR and optical studies (St. Petersburg, Russia, Ioffe Physical-Technical Institute)

Репортерское сообщение по стендовым докладам

13⁰⁰ – 14⁰⁰ Перерыв

14⁰⁰ – 15⁰⁰ Представление стендовых докладов секции «Электронные и оптические явления в наноструктурированных диэлектриках» (С4) (Малый холл корпуса 5)

- С.4.1 Антропов И.М., Демидович Г.Б., Козлов С.Н. Адсорбционная чувствительность нанокompозита «пористый кремний - никель» к метану
- С.4.2 Антропов И.М., Демидович Г.Б., Козлов С.Н., Ганьшина Е.А. Влияние адсорбции парабензохинона на магнитооптические свойства нанокompозита «пористый кремний - никель», «пористый кремний - кобальт»
- С.4.3 Барышников С.В., Шацкая Ю.А., Чарная Е.В., Патрушев Ю.В. Исследования нанопористых пленок МСМ-41, заполненных нитритом натрия, методом тепловых шумов
- С.4.4 Беломестных В.Н., Теслева Е.П. Структурно-фазовое поведение азотсодержащих ионно-молекулярных кристаллов натрия
- С.4.5 Вартамян Т.А., Ващенко Е.В., Леонов Н.Б., Пржибельский С.Г., Хромов В.В. Проводимость через ловушки в диэлектрических подложках SiO₂ и Al₂O₃, активированная нанесенными на них металлическими наночастицами серебра
- С.4.6 Гасенкова И.В., Жвавый С.П., Мухуров Н.И. Структуры на основе анодного оксида алюминия для датчиков с использованием гигантского комбинационного рассеяния

- C.4.7 Голоудина С.И., Ефременко А.М., Ильин В.А., Романов А.С., Севостьянов Е.Н. Исследование нанослоевых структур диэлектрик-кремний методом емкостной сканирующей зондовой микроскопии
- C.4.8 Гурьянов А.М. Эллипсометрия переходных слоев в пленочных микро- и наноструктурах с диэлектрическими слоями на основе оксидов редкоземельных элементов
- C.4.9 Жачкин В.А., Богомолова Л.Д., Тарасова В.В. Наноструктурные образования в ион-имплантированных диэлектрических стёклах, пригодных для захоронения ядерных отходов
- C.4.10 Иванова Е.В., Заморянская М.В., Ситникова А.А. Формирование нанокластеров кремния в диоксиде кремния при облучении электронным пучком и при высокотемпературном отжиге в вакууме
- C.4.11 Логачева В.А., Герасименко Ю.В., Хоник С.В., Афонин Н.Н., Ховив А.М. Синтез и свойства наноструктурированных пленок Co/TiO_2
- C.4.12 Максимова О.Г., Петрова Т.О. Компьютерное моделирование сегнетоэлектрических систем
- C.4.13 Мухуров Н.И., Жвавый С.П., Гасенкова И.В., Остапенко Е.В., Мазуренко Н.И. Получение анодного оксида алюминия в комбинированном электролите
- C.4.14 Нестеров А.А., Волнянский М.Д., Трубицын М.П. Тепловые и электрические свойства стеклокерамики на основе $\text{Li}_2\text{Ge}_7\text{O}_{15}$
- C.4.15 Никифоров Д.К., Коржавый А.П., Никифоров К.Г. Моделирование инжекционных топз в наноструктурах на основе нитрида алюминия
- C.4.16 Семенов А.В., Кузнецова М.А., Соколова И.М. Структура и свойства наноразмерных пленок оксидов меди, сформированных в разных режимах термообработки на воздухе
- C.4.17 Сиклицка А.В., Ястребов С.Г. Трансформация нанокластеров алмаза в наноулитоны при отжиге
- C.4.18 Фам Тхи Хаи Мьен. Оптические свойства нанокристаллов сульфида кадмия, полученных золь-гель методом

15⁰⁰ – 17³⁰ **Второе заседание секции «Процессы переноса, накопления и релаксации заряда в диэлектриках» (П1) (Большой конференц-зал)**

Руководители секции: Ханин Самуил Давидович
(РГПУ им. А.И. Герцена)
Звягин Игорь Петрович
(МГУ им. М.В. Ломоносова)

Ученый секретарь: Попова Ирина Олеговна
(РГПУ им. А.И. Герцена)

Произносимые доклады:

- П.1.10 **Чарная Е.В.¹, Пирозерский А.Л.¹, Латышева Е.Н.¹, Лебедева Е.Л.¹, Сорокин Н.И.², Криворотов В.Ф.³, Фридман А.А.³** Исследования ионной подвижности в легированных кристаллах трифторида церия (¹Санкт-Петербург, Россия, физический факультет СПбГУ; ²Москва, Россия, Институт кристаллографии им.

А.В.Шубникова РАН; ³Ташкент, Узбекистан, Отдел теплофизики Академии наук Республики Узбекистан)

- П.1.11 **Пономарев А.Ф., Мошелев А.В.** Исследование ловушечных состояний органического диэлектрика путем измерения ВАХ в термодинамически неравновесном режиме (Бирск, Россия, Бирская государственная социально-педагогическая академия)
- П.1.12 **Вейсман В.Л., Михайлов А.Г., Соловьев В.Г., Трифонов С.В., Яников М.В.** Электропроводность диэлектрических опаловых матриц (Псков, Россия, Псковский государственный университет)
- П.1.13 **Павленко А.В., Турик А.В.** Диэлектрическая релаксация в параэлектрической области керамики феррониобата свинца (Ростов-на-Дону, Россия, НИИ физики Южного федерального университета)
- П.1.14 **Badalyan A.G.¹, Azamat D.², Dejneka A.², Trepakov V.A.¹, Rosa J.², Jastrabik L.²** The Charge Alterations of Chromium Ion Impurity in SrTiO₃ Single Crystals (¹St.Petersburg, Russia, Ioffe Physical-Technical Institute; ²Prague, Czech Republic, Institute of Physics)
- П.1.15 **Гуртовой В.Г.¹, Шелег А.У.¹, Кулешов Н.В.²** Диэлектрические свойства оптически нелинейных кристаллов Er_xYb_yY_{1-x-y}Al₃(BO₃)₄ (Минск, Республика Беларусь, ¹ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», ²НИИ оптических материалов и технологий БНТУ)
- П.1.16 **Бочкова Т.М., Пляка С.Н.** Процессы формирования объемных зарядов в кристаллах ортогерманата висмута (Днепропетровск, Украина, Днепропетровский национальный университет)
- П.1.17 **Arsic N.¹, Osmokrovic P.²** The influence of the gas insulation parameters on the functioning of the three-electrode spark gap with a third electrode being inside the main electrode (¹Kosovska Mitrovica, Serbia, Faculty of Technical Sciences; ²Belgrade, Serbia, Faculty of Electrical Engineering)
- П.1.18 **Arsic N.¹, Osmokrovic P.²** Delay times of the three-electrode spark gaps in relation with the insulating parameters (¹Kosovska Mitrovica, Serbia, Faculty of Technical Sciences; ²Belgrade, Serbia, Faculty of Electrical Engineering)
- П.1.19 **Семенов А.В., Крамар Г.П., Мухин Н.В.** Длинновременные релаксационные процессы в тонкопленочных конденсаторах на основе цирконата-титаната свинца

Репортерское сообщение по стендовым докладам

15⁰⁰ – 17³⁰ **Заседание секции «Электронные и оптические явления в наноструктурированных диэлектриках» (П4) (Дискуссионный зал)**

Руководители секции: Афанасьев Валентин Петрович
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

Немов Сергей Александрович
(СПбГПУ)

Ученый секретарь: Пронин Владимир Петрович
(РГПУ им. А.И. Герцена)

Произносимые доклады:

- П.4.1 **Feofilov S.P.¹, Kulinkin A.B.¹, Zakharchenya R.I.¹, Gacoin T.², Mialon G.², Meltzer R.S.³, Dujardin C.⁴** Fluorescence of insulating crystals and nanocrystals

doped with Ce^{3+} ions: excitation mechanisms and the dependence on the surrounding gas pressure (¹St. Petersburg, Russia, Ioffe Physical-Technical Institute; ²Palaiseau, France, Ecole Polytechnique – CNRS; ³Athens, USA, Department of Physics and Astronomy, University of Georgia; ⁴Lyon, France, Université de Lyon)

- П.4.2 **Иванова Е.В., Загорянская М.В., Ундалов Ю.К., Гусев О.Б., Кукин А.В.** Нанокластеры кремния в пленках SiO_x , полученных методом магнетронного распыления (Санкт-Петербург, Россия, Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе)
- П.4.3 **Мухуров Н.И., Жвавый С.П., Гасенкова И.В.** Фотолюминесценция анодного оксида алюминия, полученного в растворах серной кислоты (Минск, Беларусь, Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси)
- П.4.4 **Старовойтов А.А.¹, Белотицкий В.И.², Кумзеров Ю.А.², Сысоева А.А.²** Оптические свойства цианиновых красителей, внедренных в макроскопический набор параллельных наноканалов (Санкт-Петербург, Россия, ¹Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, ²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН)
- П.4.5 **Петров А.А.¹, Федоров К.А.¹, Воротилов К.А.², Афанасьев П.В.¹** Исследование влияния поляризации на фотоэлектрические характеристики наноструктурированных пленок ЦТС, сформированных по различной технологии (¹Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ"; ²Москва, Россия, Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет))
- П.4.6 **Перевалов Т.В., Иванов М.В., Гриценко В.А.** Электронные и оптические свойства HfO_2 по данным квантово-химического моделирования (Новосибирск, Россия, Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН)
- П.4.7 **Бордонский Г.С., Гурулев А.А., Орлов А.О., Щегрина К.А.** Свойства воды в нанопорах МСМ-41 при температурах ниже 0°C (Чита, Россия, Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН)
- П.4.8 **Грабов В.М., Пронин В.П.** Закономерности изменения свойств диэлектриков при переходе от макроскопических систем к наноструктурам (Санкт-Петербург, Россия, РГПУ им. А. И. Герцена)
- П.4.9 **Tiagulskiy S.I.¹, Tyagulskiy I.P.¹, Nazarov A.N.¹, Rymarenko N.L.¹, Nazarova T.M.², Lysenko V.S.¹, L. Rebohle³, J. Lehmann³, W. Skorupa³** Electroluminescence thermal dependences for a rare earth implanted SiO_2 layers (¹Kyiv, Ukraine, Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine; ²Kyiv, Ukraine, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"; ³ Dresden, Germany, Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung, Forschungszentrum Dresden-Rossendorf)

Репортерское сообщение по стендовым докладам

25 МАЯ, СРЕДА

- 9⁰⁰ – 10⁰⁰ Представление стендовых докладов секций «Оптика и спектроскопия диэлектриков» (С2) и «Аморфные и стеклообразные диэлектрики» (С5) (Малый холл корпуса 5)
- C.2.1 Maksimova T.I., Kitaev Yu.E., Hermanowicz K., Maczka M. and Hanuza J. Raman scattering study of structural phase transitions in ferroelastic $K_3Na(CrO_4)_2$
- C.2.2 Malakhovskii A.V., Sukhachev A.L., Vasil'ev A.D., Leont'ev A.A., Kartashev A.V., Temerov V.L., Gudim I.A. Influence of partial substitution of iron by gallium on optical properties of $GdFe_3(BO_3)_4$
- C.2.3 Аванесян В.Т., Баранова Е.П., Потачев С.А. Диэлектрическая спектроскопия высокоомных поликристаллических слоев ортоплюмбата свинца Pb_3O_4
- C.2.4 Аванесян В.Т., Горелкина Т.Г., Диброва М.Г. Фотополяризационные явления в электролюминесцентных слоях $ZnS(Cu)$
- C.2.5 Арямин Е.Е., Залётов А.Б., Ильяшенко С.Е., Каплунова Е.И., Талызин И.В. Спектральное пропускание кристаллов парателлурита в видимом и ближнем УФ диапазонах
- C.2.6 Асатрян Г.Р., Храмцов В.А., Крамущенко Д.Д., Бадиков В.В., Бадиков Д.В., Гомзин Ю.В. ЭПР ионов Ce^{3+} в монокристаллах титогаллата свинца, $PbGa_2S_4$
- C.2.7 Атакулов Ш.Б., Атакулов Б.А., Зайнолобидинова С.М., Икромжонов О.Р., Эгамбердиев Э.Э. Об анизотропии поглощения света объемом поликристаллических пленок
- C.2.8 Балакина М.Ю. Оценка величины квадратичной электрической восприимчивости и коэффициента двулучепреломления полимерных нелинейно-оптических электретов с органическими хромофорами
- C.2.9 Балтабеков А.С., Ким Л.М., Кукетаев Т.А. Оптические свойства сульфатов калия, активированных ионами переходных металлов
- C.2.10 Барабан А.П., Дмитриев В.А., Зиновьев С.В., Петров Ю.В., Тимофеева К.А. Особенности диагностики структур диэлектрик-полупроводник люминесцентными методами
- C.2.11 Бобров П.П., Кондратьева О.В. Медленные изменения диэлектрической проницаемости почв после увлажнения из сухого состояния
- C.2.12 Бобров П.П., Миронов В.Л., Кондратьева О.В., Репин А.В. Спектральная диэлектрическая модель прочносвязанной воды в монтмориллоните в диапазоне частот 1–4000 МГц
- C.2.13 Бузанов О.А., Диденко И.С., Канаева Е.С., Козлова А.П., Козлова Н.С., Симинел Н. А., Скрылева Е.А. Изотермический отжиг и оптические свойства кристаллов лантан-галлиевого танталата
- C.2.14 Бузанов О.А., Козлова Н.С., Симинел А.В., Симинел Н.А. Люминесценция кристаллов лантан-галлиевого танталата
- C.2.15 Войнов Ю.П., Горелик В.С., Морозова С.В., Умаров М.Ф. Корреляционная флуоресцентная спектроскопия структуры и состава диэлектриков – фармацевтических препаратов

- C.2.16 Гажулина А.П., Марычев М.О. Сопоставление нелинейно-оптических характеристик кристаллов семейства титанил-фосфата калия со степенью инвариантности структур этих кристаллов относительно операции инверсии
- C.2.17 Герасименко Ю.В., Логачева В.А., Ховив А.М. Структура и оптические свойства пленок диоксида титана, легированного редкоземельными и переходными металлами
- C.2.18 Горяев М.А., Смирнов А.П. Показатель преломления стеарата серебра
- C.2.19 Гудков В.В., Берсукер И.Б., Жевстовских И.В., Коростелин Ю.В., Ландман А.И. Определение параметров эффекта Яна-Теллера с помощью ультразвуковых измерений. Приложение к $T \otimes (e + t_2)$ -задаче: $ZnSe:Cr^{2+}$
- C.2.20 Гудков В.В., Берсукер И.Б., Жевстовских И.В., Суриков В.Т. Определение параметров эффекта Яна-Теллера с помощью ультразвуковых измерений. Приложение к $E \otimes e$ -задаче: $ZnSe:Fe^{2+}$
- C.2.21 Егорова А.Е., Иванов В.А., Сомов Н.В. Рост, структурные особенности и оптические свойства некоторых кристаллов семейства $KNaC_4H_4O_6 \cdot nH_2O$
- C.2.22 Зайцев С.В., Герасименко Ю.В., Ховив Д.А. Оптические свойства плёнок TiO_2 , синтезированных методом ВЧ-распыления
- C.2.23 Зайцев С.В., Дивакова Н.А., Ховив Д.А., Ховив А.М. Синтез и оптические свойства оксидной системы на основе Nb-Ti
- C.2.24 Иванов Н.Ю., Марычев М.О. Моделирование примесных кристаллов титанил-фосфата калия, легированных ниобием, цирконием, гафнием, сурьмой и расчет их псевдосимметрии
- C.2.25 Ильинский А.В., Квашенкина О.Е., Шадрин Е.Б. Металлизация гидрированием моноклинной фазы в пленках VO_2
- C.2.26 Ким Л.М., Кукетаев Т.А., Тагаева Б.С. Центры окраски в кристаллах KDP
- C.2.27 Кустов А.И., Мигель И.А. Акустомикроскопическая спектроскопия диэлектрических материалов
- C.2.28 Лабутина М.Л., Марычев М.О., Сомов Н.В. Рост, структура и нелинейно-оптические свойства кристаллов тартратов цинка и кобальта
- C.2.29 Ларионов А.Н., Воищев В.С., Ларионова Н.Н., Воищева О.В. Особенности акустической и диэлектрической релаксации в нематических жидких кристаллах
- C.2.30 Ломонова Е.Е., Кулебякин А.В., Рябочкина П.А., Сомов Н.В., Ушаков С.Н., Чабушкин А.Н., Чупрунов Е.В., Андреев П.В. Структурные и спектрально-люминесцентные свойства кристаллов стабилизированного диоксида циркония, активированных ионами Tm^{3+}
- C.2.31 Магеррамов А.М., Гаджиева Е.Г., Шукюрова А.А., Абдуллаев Р.С., Оруджов И.А. Электротермолюминесценция композиций полипропилена с бинарными сульфидами CdS/ZnS
- C.2.32 Малиненко В.П., Прокопович П.Ф., Савицкий М.П., Фёдоров А.А. Фотопроводимость анодного оксида ниобия
- C.2.33 Новиков Ю.Н., Гриценко В.А. Строение SiO_x по данным фотоэлектронной спектроскопии: эксперимент и численное моделирование
- C.2.34 Павловский М.С., Зиненко В.И., Шинкоренко А.С. Расчет динамики кристаллической решетки кристалла пирониобата кадмия

- C.2.35 Плешаков И.В., Нечитайлов А.А., Кузьмин Ю.И., Путинцев М.В., Матвеев В.В., Фофанов Я.А., Дудкин В.И. Изучение фотомагнитного эффекта в прозрачном магнитоупорядоченном диэлектрике FeVO_3 методом ЯМР-спектроскопии
- C.2.36 Рогинский Е.М., Марков Ю.Ф. Экспериментальное и теоретическое изучение нанокластеров в смешанных кристаллах Hg_2NaI_2
- C.2.37 Скворцов А.П., Трепаков В.А., Лагута В.В., Потучек З., Ястрабик Л. Оптическая и ЭПР-спектроскопия примесных Er^{3+} -центров в кристаллах KTaO_3
- C.2.38 Тазенков Б.А., Анискина Л.Б., Батаргалиева А.Т., Карулина Е.А., Чистякова О.В. Экспериментальное уточнение структуры электромагнитной волны при полном внутреннем отражении на границе диэлектриков
- C.2.39 Трубицын М.П., Волнянский М.Д., Долинчук А.Н. ЭПР кристаллов $\text{Li}_2\text{Ge}_7\text{O}_{15}:\text{Cu}$ в окрестности сегнетоэлектрического фазового перехода
- C.2.40 Шаяпов В.Р., Аюпов Б.М. Математическое моделирование и измерение оптическими методами клиновидности диэлектрических пленок
- C.2.41 Широков В.Б., Головки Ю.И., Мухортов В.М. Спектры пропускания барий-стронциевых тонких пленок в области края поглощения
- C.2.42 Юрков А.С. О ядерном магнитоэлектрическом резонансе в тетрагональной фазе ниобата калия
- C.2.43 Ящуржинская О.А., Бухбиндер Т.Л., Немов С.А. Оптическая и ЭПР-спектроскопия ион-радикальных солей на основе тетрацианхинодиметана
- C.5.1 Афанасьев П.В., Коньков О.И., Селюженко Н.А., Теруков Е.И. Фотоэлектрические и люминесцентные свойства наноструктурированных пленок аморфного гидрогенизированного кремния
- C.5.2 Боброва Е.А., Грачева И.Е., Филатова М.В. Изучение твердых тканей зуба методом атомно-силовой микроскопии
- C.5.3 Бордовский Г.А., Марченко А.В., Гладких П.В., Дашина А.Ю., Зайцева А.В., Кожокар М.Ю., Налетко А.С. Примесные центры олова и иода в стеклообразных халькогенидах мышьяка
- C.5.4 Гудь В.Н., Колупаев Б.С., Малиновский Е.В. Влияние радиационного облучения на диэлектрические свойства аморфных полимеров
- C.5.5 Казакова Л.П., Козюхин С.А., Константинова Н.Н., Лебедев Э.А. Фефелов С.А., Цэндин К.Д. Различия в эффектах переключения и памяти на микронных и наноразмерных слоях халькогенидных стеклообразных полупроводников состава $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$
- C.5.6 Камынин А.А., Гриднев С.А. Температурная зависимость локального параметра порядка в релаксоре $\text{PbFe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5}\text{O}_3$
- C.5.7 Грабко Г.И. Диэлектрический отклик аморфных слоев As_2Se_3 , приготовленных разными методами
- C.5.8 Грабко Г.И., Татуревич Т.В. Влияние технологического фактора на процесс релаксации тока в аморфных слоях системы As-Se
- C.5.9 Кочервинский В.В., Козлова Н.В., Хныков А.Ю., Шмакова Н.А. Структурные особенности фазовых переходов порядок-беспорядок в сополимерах винилиденфторида

- C.5.10 Марченко А.В., Гладких П.В., Дземидко И.А., Еремин И.В., Кожокарь М.Ю., Серегин П.П., Теруков Е.И. Определение состава халькогенидных стекол $As_x(Ge_ySe_{1-y})_{1-x}$ методом рентгенофлуоресцентного анализа
- C.5.11 Морозова Л.В., Попов В.П. Синтез и исследование хромомагнетической шпинели ($MgCr_2O_4$)
- C.5.12 Певзнер Б.З., Немов С.А., Бородзюля В.Ф. Поликатионный эффект в стеклах $xR_2O \cdot (1-x)RO \cdot 2B_2O_3$, R = Na, Mg, Ba
- C.5.13 Пономарева А.А., Мошников В.А., Suchanek G. Особенности оптических свойств фрактальных структур золь-гель наноконкомпозитов
- C.5.14 Спивак Ю.М., Мараева Е.В., Мошников В.А. Анализ особенностей наноструктурирования селенида свинца оксидными фазами

10⁰⁰ – 13⁰⁰ **Первое заседание секции «Оптика и спектроскопия диэлектриков» (П2) (Большой конференц-зал)**

Руководители секции: Аванесян Вачаган Тигранович
(РГПУ им. А.И. Герцена)
Марков Юрий Федорович
(ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН)

Ученый секретарь: Чистякова Ольга Викторовна
(РГПУ им. А.И. Герцена)

Произносимые доклады:

- П.2.1 **Горелик В.С.** Оптика и спектроскопия глобулярных фотонных кристаллов, заполненных диэлектриками (Москва, Россия, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН)
- П.2.2 **Селькин А.В.¹, Уклеев Т.А.¹, Меньшикова А.Ю.², Шевченко Н.Н.²** Упругое рассеяние света на статистических неоднородностях опалоподобного фотонного кристалла в условиях резонансной многоволновой дифракции (Санкт-Петербург, Россия, ¹Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, ²Институт высокомолекулярных соединений РАН)
- П.2.3 **Марковин П.А.¹, Гужва М.Е.¹, Леманов В.В.¹, Раздобарин А.Г.¹, Itoh M.²** Индуцированная полярная фаза в квантовых параэлектриках (¹Санкт-Петербург, Россия, ФТИ им. А.Ф. Иоффе; ²Nagatuta, Midori, Yokohama, Japan, Tokyo Institute of Technology)
- П.2.4 **Аванесян В.Т., Водкайло Е.Г., Потачев С.А.** Оптическая спектроскопия и электрофизические свойства полимерной структуры на основе комплекса Cu (II) (Санкт-Петербург, Россия, РГПУ им. А.И. Герцена)
- П.2.5 **Djurdjević D.Ž.** Beam propagation method modelling of dielectric waveguides in photonics and nanophotonics (Kosovska Mitrovica, Serbia, Faculty of Technical Sciences)
- П.2.6 **Лушин Е.Н.¹, Петреков П.В.²** Дисперсия диэлектрических параметров полимерных композиционных материалов на основе тетразола (¹Санкт-Петербург, Россия, РГПУ им. А.И. Герцена; ²Бийск, Россия, Бийский технологический институт)

- П.2.7 **Никонорова Н.А., Якиманский А.В.** Диэлектрическая спектроскопия гребнеобразных хромофорсодержащих сополиметакрилатов, обладающих нелинейными оптическими свойствами (Санкт Петербург, Россия, Институт Высокмолекулярных соединений РАН)
- П.2.8 **Разбирин Б.С.¹, Шека Е.Ф.², Нельсон Д.К.¹, Старухин А.Н.¹, Дегунов М.Ю.¹, Шуков И.В.¹** Селективная лазерная спектроскопия замороженных растворов производных фуллерена C₆₀ (¹Санкт-Петербург, Россия, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН; ²Москва, Россия, Российский университет дружбы народов)
- П.2.9 **Krylova S.N.¹, Krylov A.S.¹, Vtyurin A.N.¹, Laptash N.M.²** Raman scattering study temperature transitions of (NH₄)₃ZrF₇ crystal (¹Krasnoyarsk, Russia, Kirensky Institute of Physics SB RAS; ²Vladivostok, Russia, Institute of Chemistry FEB RAS)

Репортерское сообщение по стендовым докладам

10⁰⁰ – 13⁰⁰ **Заседание секции «Аморфные и стеклообразные диэлектрики» (П5)**
(Дискуссионный зал)

Руководители секции: Теруков Евгений Иванович
(ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН)
Серегин Павел Павлович
(РГПУ им. А.И. Герцена)

Ученый секретарь: Марченко Алла Валентиновна
(РГПУ им. А.И. Герцена)

Произносимые доклады:

- П.5.1 **Цэндин К.Д.** Современное состояние физики эффектов переключения и памяти в халькогенидных стеклообразных полупроводниках (Санкт-Петербург, Россия, ФТИ им. А. Ф. Иоффе)
- П.5.2 **Грачева И.Е., Мошников В.А.** Особенности получения материалов с иерархической пористой структурой золь-гель методами (Санкт-Петербург, Россия, ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им.В.И. Ульянова (Ленина)")
- П.5.3 **Теруков Е.И.¹, Никитин С.Е.¹, Николаев Ю.А.¹, Кулова Т.Л.², Скундин А.М.², Манабаев Н.³** Исследование внедрения лития в тонкие аморфные слои оксидов ванадия (¹Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН; ²Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН; ³НИИЭТФ Казахский национальный университет им. аль-Фараби)
- П.5.4 **Гусев О.Б., Манабаев Н.К., Трапезникова И.Н., Ундалов Ю.К., Андреев Б.А., Яблонский А.Н.** Нанокластеры аморфного кремния в матрице SiO_x, полученные магнетронным распылением
- П.5.5 **Шулумба Н.А., Ястребов С.Г.** Особенности спектров поглощения аморфного и нанокристаллического кремния (Санкт-Петербург, Россия, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН)
- П.5.6 **Бордовский В.А., Марченко А.В., Кожокарь М.Ю., Гладких П.В, Дашина А.Ю., Серегин П.П.** Определение состава бинарных халькогенидных стекол методом рентгенофлуоресцентного анализа (Санкт-Петербург, Россия, РГПУ им. А.И. Герцена)

- П.5.7 **Пайзуллаханов М.С.** Изоляторы на основе стеклокристаллических материалов (Ташкент, Узбекистан, Институт материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз)
- П.5.8 **Литинский Г.Б.** Фактор кирквуда жидкости дипольных твёрдых сфер. Теория ассоциативных равновесий (Харьков, Украина, Национальный университет гражданской защиты)
- П.5.9 **Cyril Koughia,^{1,a)} Andy Edgar², Christopher R. Varoy,² and Safa Kasap¹** Thermodynamical and Optical Properties of Scintillating Samarium-Doped Fluorochlorozirconate Glass Ceramics (¹Department of Electrical and Computer Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada; ² School of Chemical and Physical Sciences and MacDiarmid Institute, Victoria University of Wellington, Kelburn Parade, New Zealand)

Репортерское сообщение по стендовым докладам

13⁰⁰ – 14⁰⁰ Перерыв

14⁰⁰ – 15⁰⁰ Представление стендовых докладов секции «Электретный эффект и его применение» (С7) (Малый холл корпуса 5)

- C.7.1 Dmitry Rychkov and Reimund Gerhard Positive charge stability on PTFE films treated with titanium-tetrachloride vapour
- C.7.2 Анисимова Н.И., Бордовский В.А., Сельдяев В.И. Токи термостимулированной деполяризации в оксиде висмута
- C.7.3 Борисова М. Э., Галиханов М.Ф., Дроздова Е.Е. Влияние нанодобавок в виде алюминиевой пудры на стабильность электретного состояния ПЭВД
- C.7.4 Гороховатский Ю.А., Мелешкина Н.Ю., Кочервинский В.В., Чвалун С.Н. Исследование стабильности поверхностного потенциала пленок полилактида
- C.7.5 Диканский Ю.И., Ерин К.В., Куникин С.А. Исследование ориентационных процессов в жидких диэлектриках с магнитными коллоидными частицами
- C.7.6 Костишин В.Г., Шипко М.Н., Степович М.А. Особенности короноэлектретного эффекта в феррит-гранатовых монокристаллических пленках
- C.7.7 Кузнецов А.Е., Рычков А.А., Дергачев В.Ф. Электретные свойства полиэтилена, модифицированного парами тетрахлорида титана
- C.7.8 Малышкина О.В., Мовчикова А.А., Барабанова Е.В., Белоусов А., Пугачев С.И., Эмбиль И.А. Распределение поляризации в керамике ЦТС-19, подвергнутой естественному старению
- C.7.9 Мелешкина Н.Ю., Бобрицкая Е.И. Токи термостимулированной деполяризации в пленках полилактида
- C.7.10 Миллер А.И., Гусев А.А., Вербенко И.А. Частотные зависимости диэлектрической проницаемости сегнетопьезоэлектриков, полученных с использованием механохимической активации
- C.7.11 Мусралиева Ю.Ж., Иванов В.А., Жигаева И.А. Исследование термостимулированной релаксации потенциала в пленках Ф-32Л
- C.7.12 Новиков Г.К., Федчишин В.В., Говорин И.М., Хмельков Д.О., Чекуленко И.П. Электретный эффект и электрически активные центры захвата носителей заряда в кристаллах слюды

С.7.13 Шмелев Г.К., Богомолов А.А., Солнышкин А.В. Дисперсия диэлектрических характеристик неполяризованных и поляризованных композитов на основе P(VDF-TrFE) с включениями сегнетоэлектрической керамики ЦТБС-3

15⁰⁰ – 17³⁰ **Второе заседание секции «Оптика и спектроскопия диэлектриков» (П2) (Большой конференц-зал)**

Руководители секции: Аванесян Вачаган Тигранович
(РГПУ им. А.И. Герцена)
Марков Юрий Федорович
(ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН)
Ученый секретарь: Чистякова Ольга Викторовна
(РГПУ им. А.И. Герцена)

Произносимые доклады:

П.2.10 **Щербина В.В.¹, Шандаров С.М.¹, Анисимов Д.О.¹, Бородин М.В.¹, Серебренников Л.Я.¹, Коханчик Л.С.², Козик В.В.³, Кузнецова С.А.³** Нелинейные оптические эффекты в планарных периодических доменных структурах, сформированных в ниобате лития (¹Томск, Россия, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники; ²Черноголовка, Россия, Институт проблем технологии микроэлектроники Российской академии наук; ³Томск, Россия, Томский государственный университет)

П.2.11 **Вендик И.Б.¹, Вендик О.Г.¹, Афанасьев В.П.¹, Соколова И.М.¹, Чигирев Д.А.¹, Кастро Р.А.²** Релаксационная модель динамических механических и диэлектрических характеристик полимерных материалов (Санкт-Петербург, Россия, ¹Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», ²Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена)

П.2.12 **Tolmachev D.O., Romanov N.G., Gurin A.S., Badalyan A.G., Babunts R.A., Baranov P.G.** Recombination luminescence in CsBr-based X-ray storage phosphors (St. Petersburg, Russia, Ioffe Physical-Technical Institute, Russian Academy of Sciences)

П.2.13 **Vtyurin A.N.¹, Krylov A.S.¹, Krylova S.N.¹, Oreshonkov A.S.¹, Goryainov S.V.², Voronov V.N.¹** Raman scattering study temperature and high pressure phase transitions of Rb₂KInF₆ crystal (¹Krasnoyarsk, Russia, Kirensky Institute of Physics SB RAS; ²Novosibirsk, Russia, Institute of Mineralogy and Petrography SB RAS)

П.2.14 **Федотов В.Г.** Трёхмерные фотоннокристаллические плёнки и гетероструктуры на их основе: эффекты многоволновой дифракции (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН)

П.2.15 **Командин Г.А.¹, Породинков О.Е.¹, Сигаев В.Н.²** Терагерцовая диэлектрическая спектроскопия лантан-бор-германатных стёкол (Москва, Россия, ¹Учреждение Российской академии наук Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ²Центр оптического стекла РХТУ им. Д.И. Менделеева)

П.2.16 **Афанасьев В.П.¹, Кастро Р.А.², Максимов В.А.¹, Соколова И.М.¹, Чигирев Д.А.¹** Низкочастотная диэлектрическая спектроскопия эпоксидных компаундов с наполнителем (Санкт-Петербург, Россия, ¹Санкт-Петербургский

государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", ²Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена)

- П.2.17 **Колесникова Е.М.^{1,2}, Крылов А.С.¹, Софронова С.Н.^{1,2}, Исаенко Л.И.³, Александров К.С.¹** Экспериментальное и теоретическое исследование динамики решетки оксифторида $Rb_2KMoO_3F_3$ (¹Красноярск, Россия, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН; ² Красноярс, Россия, Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф.Решетнева; ³Новосибирск, Россия, Институт геологии и минералогии СО РАН)
- П.2.18 **Рогинский Е.М.¹, Квасов А.А.², Марков Ю.Ф.¹, Смирнов М.Б.²** Динамика решеток, фононы и их дисперсия в модельных сегнетоэластиках Hg_2Cl_2 , Hg_2Br_2 (Санкт-Петербург, Россия, ¹Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, ²Санкт-Петербургский государственный университет)

Репортерское сообщение по стендовым докладам

15⁰⁰ – 17³⁰ **Заседание секции «Электретный эффект и его применение» (П7)**
(Дискуссионный зал)

Руководители секции: Борисова Маргарита Эдуардовна (СПбГПУ)
Рычков Андрей Александрович
(РГПУ им. А.И. Герцена)

Ученый секретарь: Анискина Людмила Борисовна
(РГПУ им. А.И. Герцена)

Произносимые доклады:

- П.7.1 **Рычков А.А.** Электретный эффект в неполярных полимерах: факторы, определяющие стабильность гомозаряда (Санкт-Петербург, Россия, НИИ Физики РГПУ им. А.И. Герцена)
- П.7.2 **Лучейкин Г.А.** Электреты: успехи и перспективы (Москва, Россия, Московский государственный университет приборостроения и информатики (МГУПИ))
- П.7.3 **Яблоков М.Ю.¹, Кечекьян А.С.¹, Гильман А.Б.¹, Кузнецов А.Е.²** Механоэлектретирование нанокмпозиционных материалов на основе полипропилена (¹Москва, Россия, Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова; ²Санкт-Петербург, Россия, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена)
- П.7.4 **Бурда В.В.¹, Галиханов М.Ф.², Гороховатский И.Ю.¹, Карулина Е.А.¹, Чистякова О.В.¹** Электретное состояние в композитных материалах на основе полиэтилена высокого давления с нанодисперсными наполнителями SiO_2 (¹Санкт-Петербург, Россия, РГПУ им. А.И. Герцена; ²Казань, Россия, Казанский государственный технологический университет)
- П.7.5 **Сергеева А.Е., Федосов С.Н.** Переключение поляризации и пироэлектрическая активность в поливинилиденфториде (Одесса, Украина, Одесская национальная академия пищевых технологий)
- П.7.6 **Анискина Л.Б., Викторovich А.С., Тазенков Б.А.** Взаимосвязь влажности и степени кристалличности пленок и волоконитов на основе полиэтилена и полипропилена (Санкт-Петербург, Россия, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена)

- П.7.7 **Дымова М.А., Галиханов М.Ф., Дебердеев Р.Я.** Влияние аэросила на электретные свойства вспененного полиэтилена (Казань, Россия, РТ, ГОУ ВПО Казанский государственный технологический университет)
- П.7.8 **Гольдаде В.А.¹, Зотов С.В.¹, Рычков А.А.², Иванов В.А.², Максимова Н.В.²** Термостимулированная поляризация и деполяризация полимеров в структурах металл – полимер – металл (¹Гомель, Беларусь, ИММС им. В.А. Белого НАНБ; ²Санкт-Петербург, Россия, НИИ физики РГПУ им. А.И. Герцена)
- П.7.9 **Анискина Л.Б., Викторovich А.С., Карулина Е.А., Тазенков Б.А., Темнов Д.Э., Чистякова О.В.** Применение полиэлектролитной модели для объяснения механизма выпрямления полимерных цепей волокнитов на основе полиэтилена и полипропилена (Санкт-Петербург, Россия, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена)
- П.7.10 **Ruy Alberto Pisani Altafim^{1,2}, Dmitry Rychkov^{2,3}, Heitor Cury Basso¹, Ruy Alberto Correa Altafim¹ and Reimund Gerhard²** Ferroelectret from laminated Low Density polyethylene films. (¹Sao Carlos, Brazil, University of Sao Paulo; ²Potsdam, Germany, University of Potsdam; ³St-Petersburg, Russia, Herzen State Pedagogical University of Russia)

Репортерское сообщение по стендовым докладам

19⁰⁰ Товарищеский ужин

26 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

- 9⁰⁰ – 10⁰⁰ Представление стендовых докладов секций «Диэлектрики в экстремальных условиях» (С8) и «Полимерные композиционные диэлектрики» (С6) (Малый холл корпуса 5)
- С.8.1 **Андрюшин К.П., Шилкина Л.А., Петров К.Ю., Резниченко Л.А.** Эволюция диэлектрических спектров твёрдых растворов трехкомпонентной системы $(\text{Na}, \text{K}, \text{Cd}_{0.5})\text{NbO}_3$ при увеличении содержания ниобата кадмия
- С.8.2 **Атакулов Ш.Б., Зайнолобидинова С.М., Расулов Р.Т., Тухтаматов О.А., Тошбоев Д.А.** Исследование механизма взаимодействия носителей заряда с заряженной границей зерен в поликристаллах методом изучения поперечного эффекта Нернста-Эттингсгаузена
- С.8.3 **Васильев А.П., Мурашев Б.А.** Анализ повреждаемости изоляции энергооборудования электрических станций и подстанций в условиях мокрого снега
- С.8.4 **Веселова Е.М., Ванина Е.А.** Пострадиационное распределение точечных дефектов в диэлектрических материалах
- С.8.5 **Горин Ю.В.** Модификация диэлектрических структур электрическими разрядами
- С.8.6 **Графутин В.И., Илюхина О.В., Мясичева Г.Г., Прокопьев Е.П., Савельев Г.И., Фунтиков Ю.В., Хмелевский Н.О.** Определение концентраций радиационных дефектов в пластинах кремния р-типа по разностным значениям интенсивностей компонент I_p и I_g в спектрах УРАФ
- С.8.7 **Емельянов О.А.** Модель теплового пробоя диэлектрика

- C.8.8 Клымента Д.О., Евтич М.Д., Радосавлевич Й.Н., Анисимова О.А. Моделирование свойств изоляции ПВХ кабелей для нужд термического анализа короткого замыкания
- C.8.9 Кравченко О.Ю., Резниченко Л.А., Дудкина С.И. Диэлектрические спектры твёрдых растворов бинарной системы на основе ниобатов натрия-лития
- C.8.10 Кревчик В.Д., Семенов М.Б., Зайцев Р.В., Гаврина З.А. Влияние диэлектрической матрицы на управляемость 2d-туннельного переноса и оптических свойств квантовых молекул в условиях внешнего электрического поля
- C.8.11 Кугаенко О.М., Петраков В.С., Уварова С.С., Бузанов О.А., Егоров В.Н., Сахаров С.А. Разрушение кристаллов лантан-галлиевого танталата при механических циклических воздействиях
- C.8.12 Мельникова Н.В., Бабушкин А.Н. Импедансная спектроскопия стеклообразных материалов $Cu_{1-x}Ag_xGeAsSe_3$ при высоких давлениях
- C.8.13 Мехрабова М.А. Модель дефектообразования в слоистых полупроводниках при облучении ионизирующей радиацией
- C.8.14 Павелко А.А., Андриюшин К.П., Алёшин В.А., Шилкина Л.А., Павленко А.В. Влияние модификации феррита висмута редкоземельными элементами на термическую устойчивость, микроструктуру и электропроводность его твердых растворов
- C.8.15 Прокопьев Е.П. Аннигиляция позитронов на F'_+ - центрах в ионных кристаллах и кварце
- C.8.16 Садыков Х.А., Вербенко И.А., Алешин А.В., Дудкина С.И. Особенности свойств бессвинцовых сегнетопъезокерамических материалов, модифицированных $SrO+TiO_2$, $CuO+TiO_2$ и CdO , в сильных смещающих полях
- C.8.17 Столяров А.А., Андреев Д.В., Васютин М.С. Моделирование воздействия ионизирующих излучений на диэлектрические пленки МДП-структур, находящихся в режиме сильнополевой инжекции
- C.6.1 Topchiyeva Sh.A., Mehrabova M.A., Hasanov N.H. Radiation effect onto biodiversity of spiders
- C.6.2 Аблеев Р.И., Валиев А.Р., Рамш А.С., Курлянд С.К. Диэлектрическая спектроскопия термоэластопластов на основе полипропилена и различных каучуков
- C.6.3 Бобрицкая Е.И., Добровольская И.П., Попрядухин П.В. Влияние наноразмерных добавок хризотила и монтмориллонита на проводимость и диэлектрические свойства хитозановой матрицы
- C.6.4 Ваганов Г.В., Юдин В.Е., Машляковский Л.Н., Евтюков Н.З. Влияние процесса диспергирования природных наночастиц на свойства эпоксидных порошковых композиционных материалов
- C.6.5 Вахонина Т.А., Шарипова С.М., Иванова Н.В., Фоминых О.Д., Смирнов Н.Н., Якиманский А.В., Балакина М.Ю. Исследование нелинейно-оптических свойств метакрилатных полимеров и сополимеров с азохромофорами в боковой цепи
- C.6.6 Гороховатский Ю.А., Гулякова А.А. Исследование термостимулированной релаксации поверхностного потенциала в пленках ударопрочного полистирола с наполнителем TiO_2

- C.6.7 Гуменная Е.С. Термостимулированная и изотермическая релаксация поверхностного потенциала в композитных пленках на основе ПЭВД с BaTiO_3
- C.6.8 Карпушина Т.И., Андреев А.М. Исследование изоляции современных обмоточных проводов в процессе теплового старения
- C.6.9 Коротков Л.Н., Короткова Т.Н., Караева О.А., Лиховая Д.В., Rysiakiewicz-Pasek. Диэлектрическая релаксация в окрестностях сегнетоэлектрического фазового перехода в сополимере ВДФ₆₀/ТрФЭ₄₀ в условиях «ограниченной геометрии»
- C.6.10 Кушева И.В., Павлов Г.М., Максимов А.В. Упорядоченность и локальная подвижность в поверхностных слоях полимерных пленок с планарным дипольным порядком
- C.6.11 Максимцев Ю.Р., Колупаев Б.Б., Кривцов В.В. Влияние внешнего электрического поля на процессы поляризации пластифицированного поливинилхлорида
- C.6.12 Малышкина И.А., Гаврилова Н.Д., Махаева Е.Е. Релаксация проводимости в системе поливинилкапролактама – вода
- C.6.13 Морсаков И.М., Солнышкин А.В., Кислова И.Л. Температурное поведение диэлектрических характеристик композитных материалов на основе сополимера P(VDF-TrFE) с добавлением ТГС
- C.6.14 Москалюк О.А., Цобкалло Е.С., Дарвиш Д.М. Сравнительный анализ экспериментальных и теоретических значений электрического сопротивления композиционного материала полипропилен-наночастицы технического углерода
- C.6.15 Пересторонина З.А., Омельченко А.Н., Булкина А.К., Рамш А.С., Курлянд С.К. Исследование структуры бинарных смесей методом диэлектрической спектроскопии
- C.6.16 Пересторонина З.А., Омельченко А.Н., Колобаева М.М., Груничева Е.В., Булкина А.К., Рамш А.С., Хвостик Г.М., Курлянд С.К. Диэлектрическая спектроскопия как метод исследования процессов модифицирования полимеров
- C.6.17 Петров А.А., Афанасьев П.В., Трушлякова В. Исследование полимерных композитов интегральных микросхем электронно-зондовыми методами
- C.6.18 Попрядухин П.В., Добровольская И.П. Электроформование нановолокон из алифатического сополиамида
- C.6.19 Сальникова П.Ю., Житенева Д.А., Михалчан А.А., Лысенко В.А., Лысенко А.А. Электропроводность полимерных пленок, наполненных техническим углеродом
- C.6.20 Саяпова Р.Г., Куватов З.Х., Чувьров А.Н. Диэлектрические свойства синдиотактического 1,2 – полибутадиена
- C.6.21 Темнов Д.Э., Фомичева Е.Е. Влияние аморфного диоксида кремния на электретные свойства полипропилена
- C.6.22 Темнов Д.Э., Фомичева Е.Е., Федоров Б.А., Смирнов А.В. Агломерация частиц наполнителя на основе алюминия в композитных пленках полипропилена
- C.6.23 Улитин Н.В., Дебердеев Т.Р., Чернов И.А., Новиков Г.Ф., Дебердеев Р.Я. Особенности структурных и релаксационных переходов модифицированных густосетчатых эпоксиаминных полимеров
- C.6.24 Цобкалло Е.С., Ожегова Т.С., Безбородов А.А. Влияние степени наполнения и структурных особенностей на теплопроводность композиционного материала полипропилен – технический углерод

- C.6.25 Шаманин В.В., Наследов Д.Г., Марфичев А.Ю., Большаков М.Н., Рудая Л.И. Полимерные композиции для создания сплошных и рельефных термо-, хемо- и плазмостойких диэлектрических покрытий
- C.6.26 Юдин В.Е., Бурда В.В. Влияние дисперсного SiO₂ на стабильность электретоного состояния сополимера этилена с винилацетатом (СЭВА)
- C.6.27 Якиманский А.В., Носова Г.И., Соловская Н.А., Жукова Е.В., Смирнов Н.Н. Нелинейные оптические свойства второго порядка поляризованных пленок хромофор-содержащих полимеров

10⁰⁰ – 13⁰⁰ **Заседание секции «Диэлектрики в экстремальных условиях» (П8) (Большой конференц-зал)**

Руководители секции: Закревский Владимир Александрович (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН)
 Барабан Александр Петрович (СПбГУ)

Ученый секретарь: Комаров Владимир Алексеевич (РГПУ им. А.И. Герцена)

Произносимые доклады:

- П.8.1 **Еханин С.Г., Несмелов Н.С., Солдатова Л.Ю., Томашевич А.А.** О схожести явлений электрической деградации в диэлектриках и широкозонных полупроводниках (Томск, Россия, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники)
- П.8.2 **Бондаренко П.Н., Емельянов О.А., Хабибуллин М.Р., Шемет М.В.** Прогнозирование следования ЧР (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
- П.8.3 **Куликов В.Д.** Модель канала электрического пробоя в ионных кристаллах (Томск, Россия, Томский сельскохозяйственный институт)
- П.8.4 **Садовничий Д.Н.¹, Милёхин Ю.М.¹, Лопаткин С.А.², Жгун Д.В.², Важов В.Ф.², Бутенко Е.А.¹, Малинин С.А.¹** Особенности импульсного электрического пробоя энергоемких полимерных композиций, наполненных дисперсным алюминием (¹г. Дзержинский Московской обл., Россия, ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз"; ²Томск, Россия, Томский политехнический университет)
- П.8.5 **Белько В.О., Шемет М.В.** Исследование перекрытий микрозазоров между электродами, напыленными на полимерные пленки (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
- П.8.6 **Андреев В.В.¹, Масловский В.М.², Столяров А.А.¹** Модификация зарядового состояния диэлектрических пленок МДП-структур сильнополевой инжекцией и плазменной обработкой (¹Калуга, Россия, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал; ²Зеленоград, Россия, ГУП Научно-производственный центр «Спурт»)
- П.8.7 **Klimenta D.O.¹, Jevtić M.D.¹, Anisimova O.A.², Radosavljević J.N.¹** Insulation modelling for thermal analysis of XLPE cables under short circuit conditions (¹Kosovska Mitrovica, Serbia, Faculty of Technical Sciences; ²Tomsk, Russia, Tomsk Polytechnic University)

- П.8.8 **Таланов М.В., Шилкина Л.А., Захарченко И.Н.** Аномальное поведение диэлектрической проницаемости керамик на основе сегнетоэлектриков-релаксоров в области сильных электрических полей (Ростов-на-Дону, Россия, Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета)
- П.8.9 **Кугаенко О.М., Портнов О.Г., Уварова С.С., Васильева В.А.** Анизотропия микротвердости кристаллов иодата лития гексагональной модификации (Москва, Россия, ФГОУ ВПО Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»)

Репортерское сообщение по стендовым докладам

10⁰⁰ – 13⁰⁰ **Заседание секции «Полимерные композиционные диэлектрики» (П6)**
(Дискуссионный зал)

Руководители секции: Дебердеев Рустам Якубович (Казанский ГТУ)
Цобкалло Екатерина Сергеевна (СПбГУТиД)
Ученый секретарь: Соколов Виктор Павлович (СПбГУТиД)

Произносимые доклады:

- П.6.1 **Балакина М.Ю.** Аналитическая модель релаксации макроскопической поляризации полимерных нелинейно-оптических электретов с органическими хромофорами (Казань, Россия, Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН)
- П.6.2 **Колупаев Б.Б., Клепко В.В., Лебедев Е.В.** Прохождение тока через наноккомпозиты на основе гибкоцепных полимеров (Киев, Украина, Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины)
- П.6.3 **Цобкалло Е.С.¹, Юдин В.Е.², Москалюк О.А.¹, Баланёв А.С.¹** Влияние различных видов углеродных нанонаполнителей и ориентационной вытяжки на физико-механические свойства полимерного композиционного материала (¹Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, ²Институт высокомолекулярных соединений РАН)
- П.6.4 **Topchiyeva Sh.A., Abiyev N.A., Mehrabova M.A.** Electrophysical parameters of snake venom (Baku, Azerbaijan, Institute of Zoology of ANAS, Institute of Radiation Problems of ANAS)
- П.6.5 **Верховская К.А.², Гаврилова Н.Д.¹, Лотонов А.М.¹, Плаксеев А.А.²** Стеклование полимерных пленок Ленгмюра-Блоджетт (Москва, Россия, МГУ им. М.В. Ломоносова; ²Москва, Россия. Учреждение Российской академии наук Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН)
- П.6.6 **Gulyakova A.¹, Fröbning P.², and Gorokhovatskiy Yu.¹** Relaxation Processes in High-Impact Polystyrene Films with Titanium-Dioxide Inclusions (¹St. Petersburg, Russia, Herzen State Pedagogical University; ²Potsdam, Germany, University of Potsdam)
- П.6.7 **Мякин С.В.¹, Корсаков В.Г.¹, Панова Т.И.², Фомченкова Ю.С.¹, Шилова О.А.², Соснов Е.А.¹, Васильева И.В.³, Сычев М.М.¹** Регулирование диэлектрических свойств органо-неорганических композитов (Санкт-Петербург, Россия, ¹Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), ²Институт химии силикатов РАН, ³Инженерно-технологический центр РАДИАНТ)
- П.6.8 **Караева О.А.¹, Бочаров А.И.¹, Коротков Л.Н.¹, Rysiakiewicz-Pasek².** Диэлектрическая и механическая релаксация в окрестностях температуры стеклования сополимеров винилиденфторида, внедренных в пористые матрицы

(¹Воронеж, Россия, Воронежский государственный технический университет;
²Wroclaw, Poland, Institute of Physics, University of Technology)

Репортерское сообщение по стендовым докладам

13⁰⁰ – 14⁰⁰ Перерыв

14⁰⁰ – 15⁰⁰ Представление стендовых докладов секции «Электрофизика структур, содержащих диэлектрические слои» (С3) (Малый холл корпуса 5)

- C.3.1 Poplavko Y.M., Prokopenko Y.V., Ruda N.A. Electromagnetic analysis of dielectric-air structure placed between metal plates
- C.3.2 Александров О.В., Высоцкая С.А., Поторочина А.В., Сорокин П.Б. Накопление заряда в МОП-транзисторах при рентгеновском облучении
- C.3.3 Ахмедов Р.А.¹, Расулов Д.Т.², Ирматов Ф.М.¹ Исследование пленочных фоточувствительных структур с диэлектрической прослойкой
- C.3.4 Балашова Е.В.¹, Кричевцов Б.Б.¹, Панкова Г.А.², Леманов В.В.¹ Сегнетоэлектрические пленки дейтерированного бетаинфосфита: кристаллическая и блочная структура, диэлектрические свойства
- C.3.5 Барабан А.П., Дмитриев В.А., Зиновьев С.В., Петров Ю.В., Тимофеева К.А. Люминесценция диэлектрических слоев на кремнии
- C.3.6 Барабан А.П., Гаджала А.А., Дрозд В.Е., Никифорова И.О., Прокофьев В.А. Формирование и свойства оксида тантала на кремнии
- C.3.7 Батурин С.С., Шейнман И.Л., Альтмарк А.М., Канарейкин А.Д. Использование высокопрочных микроволновых материалов в ускорительных структурах с диэлектрическим заполнением
- C.3.8 Большакова Н.Н., Быховец А.А., Черешнева Н.Н. Электрофизические свойства пьезокерами ЦТС-46
- C.3.9 Величко А.А.¹, Гришин А.М.², Савенко А.Ю.³, Харцев С.И.², Стефанович Г.Б.¹ Свойства микроструктур на основе SeO₂, полученных с использованием фокусированного ионного пучка
- C.3.10 Герасимов Р.А., Максимов А.В. Эффекты упорядочения и поляризация в полимерных сегнетоэлектрических пленках различной толщины
- C.3.11 Иванов В.В. Квазистатические процессы переключения монокристаллов триглицинсульфата
- C.3.12 Кундозерова Т.В., Параничев Д.К., Болдин П.А. Резистивное переключение в оксиде Nb
- C.3.13 Леонова Т.М., Кастро Р.А. Диэлектрические свойства МДП-структур на основе оксида алюминия
- C.3.14 Михайлов А.К., Пташник С.В., Козырев А.Б. Селективное возбуждение собственных акустических мод внешним СВЧ-полем в многослойных структурах с двумя сегнетоэлектрическими пленками
- C.3.15 Михайловский В.Ю., Суханов А.А., Яфясов А.М. Исследование системы GE/C₆₀ методами эффекта поля в электролите и инфракрасной спектроскопии

- C.3.16 Новаков И.А., Орлинсон Б.С., Брунилин Р.В., Потаёноква Е.А. Сополиимиды на основе бициклододержащих диаминов в качестве перспективных термостойких диэлектриков
- C.3.17 Параничев Д.К., Кундозерова Т.В., Болдин П.А. Моделирование вольтамперных характеристик фотогальванического элемента на основе оксида никеля
- C.3.18 Путролайнен В.В. Переключение с памятью в структуре на основе оксида ванадия
- C.3.19 Семенов А.В., Мухин Н.В. Особенности моделирования петель диэлектрического гистерезиса тонкопленочных конденсаторных структур на основе цирконата-титаната свинца
- C.3.20 Семикин Д.А., Таганцев А.К., Канарейкин А.Д. Использование поперечного электрического поля для управления свойствами сегнетоэлектрических структур
- C.3.21 Солнышкин А.В., Богомолов А.А., Канарейкин А.Г., Морсаков И.М. Пироэлектрические свойства пленок сополимера P(VDF-TRFE), поляризованных в поле коронного разряда
- C.3.22 Стукова Е.В., Сидоров Н.В., Барышников С.В. Взаимное влияние сегнетоэлектрических частиц в композитах $KNO_3-LiNbO_3$
- C.3.23 Шалимова М.Б., Ефремов А.М. Вызванное адсорбцией влаги изменение параметров МОП-структур с оксидами редкоземельных элементов
- C.3.24 Шелехов И.Ю., Шишелова Т.И. Влияние диэлектрического связующего на стабильность параметров нагревательных элементов

15⁰⁰ – 17⁰⁰ **Заседание секции «Электрофизика структур, содержащих диэлектрические слои» (ПЗ) (Большой конференц-зал)**
 Руководители секции: Коноров Павел Павлович (СПбГУ)
 Гуртов Валерий Алексеевич (ПетрГУ)
 Ученый секретарь: Карулина Елена Анатольевна
 (РГПУ им. А.И. Герцена)

Произносимые доклады:

- П.3.1 **Стефанович Г.Б.** Резистивное переключение в оксидных пленках: физика, новые применения (Петрозаводск, Россия, Петрозаводский государственный университет)
- П.3.2 **Попов В.Д.** Образование поверхностных состояний в структуре кремний-оксид кремния при сверхнизких интенсивностях гамма-излучения (Москва, Российская Федерация, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ)
- П.3.3 **Кричевцов Б.Б., Балашова Е.В., Леманов В.В.** Петли диэлектрического гистерезиса в пленках дейтерированного бетаинфосфита (Санкт-Петербург, Россия, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН)
- П.3.4 **Шалимова М.Б., Шеянова А.В.** Модификация процесса электрической деградации МОП-структур с High-K диэлектриками в условиях повышенных температур (Самара, Россия, Самарский государственный университет)
- П.3.5 **Троян П.Е., Сахаров Ю.В., Усов С.П.** Электрофизические свойства пористых пленок диоксида кремния (Томск, Россия, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники)

- П.3.6 **Гольдман Е.И., Чучева Г.В., Кухарская Н.Ф., Нарышкина В.Г., Буров А.В.** Генерация и аннигиляция центров рождения электронно-дырочных пар, возникающих в результате полевого и термического стрессов Si-МОП-структур со сверхтонким окислом (Москва, Россия, Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук)
- П.3.7 **Балашова Е.В.¹, Кричевцов Б.Б.¹, Таганцев А.К.²** Генерация второй акустической гармоники, индуцированной электрическим полем, в сегнетоэлектриках (¹Санкт-Петербург, Россия, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; ²Switzerland, Ecole polytechnique federale de Lausanne)

Репортерское сообщение по стендовым докладам

15⁰⁰ – 17⁰⁰ **Круглый стол «Физика диэлектриков в системе образования» (КС)**
(Дискуссионный зал)

Руководитель заседания: Никифоров Константин Георгиевич (КГУ)

Ученый секретарь: Анискина Людмила Борисовна
(РГПУ им. А.И. Герцена)

- КС.1 **Дикусар В.В., Тюняев А.А.** Единая теория поля и природа диэлектричества (Москва, Россия, Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН)
- КС.2 **Сидяров С.С.** Обучение студентов в вузах по теме «О значении диэлектриков в технике и производстве» (Джизак, Узбекистан, ДжГПИ)
- КС.3 **Гильмиярова С.Г.¹, Куватов З.Х.², Матвеева Л.М.², Носиков С.Е.³** Методика изучения физических основ диэлектриков (Уфа, Россия ¹Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, ²Башкирский государственный университет, ³Станция юных техников)
- КС.4 **Терукова Е.Е., Кошкина Д.В.** Разработка курса «Водородная энергетика» в рамках магистерской программы «Нанотехнология и диагностика»
- КС.5 **Поплавко Ю.М.¹, Раевский И.П.²** Новое учебное пособие «Физика активных диэлектриков» (¹Киев, Украина, Национальный технический университет «КПИ»; ²Ростов-на-Дону, Россия, Южный федеральный университет)
- КС.6 **Алексеева Н.О., Вейсман В.Л., Годунова И.В., Панькова С.В., Соловьев В.Г., Яников М.В.** Экспериментальное исследование фотонно-кристаллических наноструктур на основе диэлектрических матриц опалов методами брэгговского отражения и атомно-силовой микроскопии в вузовской физической лаборатории (Псков, Россия, Псковский государственный университет)

17³⁰ **Заккрытие конференции**

ФИЗИКА ДИЭЛЕКТРИКОВ
(Диэлектрики - 2011)

XII Международная конференция
Санкт-Петербург, 23 – 26 мая 2011 г.

Пригласительный билет и программа конференции

Подписано в печать 02.05.2011. Формат 60 x 84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 2,0 уч.-изд. л.;
2,0 усл. печ. л. Тираж 250 экз. Заказ №
Издательство РГПУ им. А.И. Герцена
191186, С.-Петербург, наб. р. Мойки, 48

Типография РГПУ им. А.И. Герцена, 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48